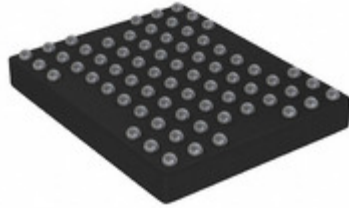





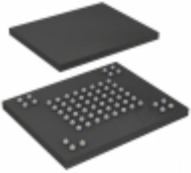



	<h2 style="color: red;">TC58NVG0S3HBAI6</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TC58NVG0S3HBAI6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TC58NVG0S3HBAI6.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4175 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen	
Teilenummer	TC58NVG0S3HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	4175 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8)
Serie	-
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Zugriffszeit	25ns
Speicherformat	FLASH
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Speicherschnittstelle	Parallel
Verpackung	Tray
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Andere Namen	TC58NVG0S3HBAI6JDH

TC58NVG0S3HBAI6 ist neu im Original, Suche TC58NVG0S3HBAI6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TC58NVG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage TC58NVG0S3HBAI6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>TC58NVG0S3ETA10B3H</b> TOSHIBA TOSHIBA TSOP</p>	 <p><b>TC58NVG0S3HTA10</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TC58NVG0S3HTA10</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TC58NVG0S3FTA00</b> TOSHIBA TC58NVG0S3FTA00 TOSHIBA</p>
 <p><b>TC58NVG0S3HBAI4</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 63TFBGA</p>	 <p><b>TC58NVG0S3HTA00</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TC58NVG0S3ETA10</b> TOSHIBA TC58NVG0S3ETA10 TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58NVG0S3HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- |                    |                      |                    |                      |                   |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| ⚙ TC58FVB160FT-10  | ↔ TC58FVB321FT-70    | ➔ TC58FVB800FT-12  | D TC58FVM5B2ATG65    | ➔ TC58FVM5B2AXG65 |
| ⊣ TC58FVM5T2ATG65  | ⚙ TC58FVM6B2ATG65    | D TC58FVM6B5BTG65  | ➔ TC58FVM6T5BTG65    | ➔ TC58FVM7T5BTG65 |
| ⚙ TC58FVT160AFT-70 | ⊣ TC58FVT160AFT70    | ⚙ TC58FVT160FT-10  | ↔ TC58FVT160FT-85    | ➔ TC58G-315-03G   |
| D TC58NC344AF      | ⚙ TC58NC5HJ8GSB-01   | ⊣ TC58NC6623G6F    | ⚙ TC58NVG0S3AFT05    | ➔ TC58NVG0S3EBAI4 |
| ➔ TC58NVG0S3EBAI7  | ↔ TC58NVG0S3EBAI7LRH | ⚙ TC58NVG0S3ETA00  | ⊣ TC58NVG0S3ETA10    | ➔ TC58NVG0S3ETA10 |
| ↔ TC58NVG0S3HBAI6  | ➔ TC58NVG0S3HTA10    | D TC58NVG0S3HTA10  | ⚙ TC58NVG0S3HTA10B4H | ⊣ TC58NVG1S3EBAI4 |
| ⚙ TC58NVG1S3EBAI5  | D TC58NVG1S3ETA00    | ➔ TC58NVG1S3ETA00  | ↔ TC58NVG1S3ETA10    | ➔ TC58NVG1S3ETA10 |
| ⊣ TC58NVG1S3ETA10  | ⚙ TC58NVG1S3HBAI4    | ↔ TC58NVG1S3HBAI4  | ➔ TC58NVG1S3HBAI6    | ➔ TC58NVG1S3HBAI6 |
| ⚙ TC58NVG1S3HTA00  | ⊣ TC58NVG1S3HTA00    | ⚙ TC58NVG2S0HTA10  | D TC58NVG2S0HTA10    | ➔ TC58NVG2S3ETA00 |
| ↔ TC58NVG2S5HBAI6  | ⚙ TC58NVG3S0FTA00B4H | ⊣ TC58NVG4D2ETA100 | ⚙ TC58NYG1S8HBAI6    | ➔ TC58NYG2S3ETA10 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited